This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	, 1979°	45			a de la la			77	THE WAY	4
P		No.	£,				No.			
*					1 - s. 3				ŧ	
				3				k _{ij}	Ec. 3	A C
1										
, Q		5								
Ē				*						4
`>-₹ X .										Å
h										7
	•									á
1										
3										
j.										. 1
				٠, '						
Ė.										* 4
b										1/4
9.										1
14										1
										4
1. 1.										4
· .										
ì										
								•		3
					•					1
										id
4										-
à :-										× 1
										1
										, į
g 2										4.4
										1
F.										V 4
										J.
12										Sec. Co.
600 P										#
100 m										3
•										. 3
1										4
Ν.,										
										*
1										
										-
, in						randra de la composição de la composição de la Maria de Maria de La Composição de la Maria de Maria de Maria d La composição de la Compo				9
										4
										i k
										1
	÷									
Ì										
Ž.										
								_	. 4	
26									و القور	

XP-002253231

AN - 1976-42485X [25]

CPY - DENK

DC - L02 L03 U12 V06

FS - CPI;EPI

IC - C04B35/00 ; H01L41/18

MC - L02-G07B L03-D01B

PA - (DENK) TDK ELECTRONICS CO LTD

PN - JP49033907 A 19740328 DW197623 000pp

- JP53031279B B 19780901 DW197839 000pp

PR - JP19720075705 19720728

XIC - C04B-035/00; H01L-041/18

AB -J49033907 Ferroelec. piezoelec. ceramic material have the formula (LixNa1-x)(TayNb1-y)O3 and compsn. that fall within the area defied by points (x,y) in teh phase diagram for the system NaNbO3-NaTaO3-LiTaO3-LiNbO3, as 0.40, 0.01; 0.01, 0.01; 0.01, 0.40; 0.20, 0.40; 0.35,0.35; 0.40, 0.20. These materials have a sufficiently large mech. quality factors (Qm) dielec. consts. (epsilon, epsilo 0) which vary over a wide rage, sufficiently low resonance impedance, extremely low temp. coeffts. of epsilon/epsilon 0 and resonance frequency, and are useful in ceramic filters of integrated circuits.

IW - FERROELECTRIC PIEZOELECTRIC CERAMIC LITHIUM SODIUM TANTALATE NIOBATE IKW - FERROELECTRIC PIEZOELECTRIC CERAMIC LITHIUM SODIUM TANTALATE NIOBATE NC - 001

OPD - 1972-07-28

ORD - 1974-03-28

PAW - (DENK) TDK ELECTRONICS CO LTD

TI - Ferroelectric piezoelectric ceramics - of lithium (sodium) tantalate (niobate)

1	
· ·	
2	
Ò.	
No.	
114	
P. C.	
i.	
4	
ľ	
144 A	
5-	
ķ.	
V.	
1	
e)	
tak sec.	
1	
1.5	



特許力

特角片反应 三

東京都千代田区内神田2丁目14番6号 化学工業株式会社内

101

東京都千代田区内神田2丁目14和

(306) 東京電気化学工業株式会社

19 日本国特許庁

49 -33907 ①特開昭

④公開日 昭49.(1974) 3.28·

②特願昭 47-25705

昭47.(1972) 7.28 **②出願日**

審查請求

(全4頁)

庁内整理番号

6730 41 6579 41

2/12 57

50日本分類

2013/2129 2013/01/4 62 CZ3

1.発明の名称

強誘電性圧電磁器材料

 $(L_{i_{\pi}} \cdot N_{a_{1-\pi}}) \cdot (T_{a_{\pi}} \cdot N_{b_{1-\pi}}) O_5$ で構成され、 x-と y の低がそれぞれ

(A) (B) (C) (U) (E)

本発明は、強帥電性圧電磁器材料に関する。 近年、圧電設動子の用途拡大により、その要 水モられる特性も多紋にわたり、きびしい圧電 特性が所謂せられる昨今、さらにすぐれた圧電

特性を有する圧電材料の開発が期待されている。

通信機用機器のIC化の一端として、インダク スの問題、すなわちコイルを使用しない機 巻の問題が活発に研究されて居り、この中でも LCフィルタに圧覚セラミックフィルタが置き わることは必至の状況である。

との場合、フイルタの種類および特性も て、かつ共扱インピーダンスおよび共振局 波数の温度係数が充分に小さいものが要求 されている。また、適用周皮数についても!宇仰 15KHg~40MHg程度まで多種多様のものが要求 されている。

本発明は、かかる要益にとたえるべくなされ たものでもり、ペロプスカイト構造を有する NaNbOsかよびNaTaOsと、イルメナイト構造を 有する Li NbOs ⇒ よび Li TaOs の 4 成分固格体 からなる主成分を有する。

すなわち、本発明は一般式 (Li Na1---)

 (T_a, N_{b_1-y}) O_b でしめされ、x とyの値が それぞれ

	. * .			y	
(A)	Q 4 0		۰	0 1	•.
(B)	Q D 1	• .		0 1	:
(C _.)	0.01		۵.	4 0	
(Ū)	a. ± o		α,	4 0	
·(E)	° 0 3 5		a .	5 5	
(P)	Q 4 D		a,	2 0	
				4	

でしめされる組成比で囲まれる組成範囲内の組成を有する強誘電性圧電材料である。

本発明の組成による磁器圧電体は、セラミックフィルタ用として好適であり、機械的 G 値が十分に大きく、酵電率 e/e。は広い範囲のものが得られ、共振インピーダンスは充分に低く、共振開放数、酵電率 (e/e。) の温度係数が広い組成範囲にわたり非常に小さく、かつ安定な特性を有するものである。

以下、本発明をさらに明確にするために、実施例をあげて、詳細に説明する。

にかける電気機械結合係数 K_p 厚み方向の電気機械結合係数 K_t かとび機械的品質係数 Q_m を測定した。 御定はI , B の 優単回路の方法に従った。 なか K_p の計算は共振 (fr) かとび反共振 (fa) から計算し、また酵電率 ** かよび勝電体損失 $(tan \delta)$ の 測定は 1 KH_s の 周波数で行なった。

第1表に、とのようにして得られた試料の種 種の組成における圧電的静定数を示した。

第1表にかいて明らかなよりに極めて高い Kp, Ktを示すほか、本発明の圧電磁器材料の組成範囲では、任意に組成比を変化させることにより Qm ヤ */*。、tan* の値も広い範囲にわたって調整することができる。

宴集例

本発明の圧電磁器材料を得るための出発原料 粉末としては特にととわらない限り $L_{i\,2}O_{5}$, $N_{a\,2}CO_{5}$, $N_{b\,2}O_{5}$, $T_{a\,2}O_{5}$ を用い、各粉末を 所定量だけ秤量し、メタノールによるボールミルで混合処理した。

ついで、900でで2時間空気雰囲気中で仮焼成した。さらにメタノールによるポールミルで設件混合した後、所定量のパインダーを加えて15ton/moの成形圧力で直径15mm、厚さ10mの円板に加圧成形する。

との円板を1100℃~1500℃の範囲の温度で 2時間空気雰囲気にかいて挽続させた。

このようにして得た磁器を圧電体として用いる場合には、周知の手段たとえば一対の AF 電 極を円板の両面に設け、 150~500℃のシリコンオイル中に入れて、 電磁間に直流電界 5~6 KV/mm を 1 時間印加して分極する。

このようにして待られた圧電磁器は、2.4時間放便の装圧電性を評価するために任方向振動

第 1 表

T	1 1	, y		1188 4	K.	- K -		11140	
-	(450)	(Es)	•	(#)	(5)	K	Qm	(p= 40	
1 (23)	201	0.01	8.9	16	3 0 2	200	1320	-74	
2	001	010	102	0.7	440	2 3 0	1506	-	
3	E01	0.2 D	120	Q 8	4 5 0	2 2 5	1600	-	
4.	0.0 1	0.30	150	0.7	400	210	1650	-	
5(1)	001	0.40	155	2 9	3 % 8	2 0 5	1 6 0 6	-	
•	405	0.10	70	1.4	449	220	1500	-35	
7	TO 2	0.20	115.	1.4	4 5 0	215	1450	~20	
8	0.05	0.50	1 6 5	1.4	406	2 0.0	1820	-54	
,	0.05	040	182	1.6	3 & S	128	1 . 7 6	- 5 1	
10	010	0.01	70	1.0	4 8.7	2 4 8	1120	-10 9	
11	010	0.10	100	1.5	4 6 5	2,25	1800	-67	
12	010	a 1 5	118	1.0	448	2 1 0	1400	-88	
15	010	0.20	120	1.0	4 3 2	209	1 4 0 0	-48	
14	010	0.25	126	1.3	4 0.5	200	1850		
15	010	D30	194	1.4	3 5.5	20.0	1900	~ 3 0	
16	010	D40	210	1.4	306	206	2000		
17	012	001	120	1.4	457	230	1200	7.4	

Æ	(* *	(- E4)	а	tan ð (ઇ)	(S)	Кр (な)	Qm	fr. TC (prin/oc
18	0.12	010	1 5 1	1.8	4 4.5	210	1850	- 5 3
19	0.16	001	160	1 6	4 0 7	210	1580	-26
20	016	010	150	2.0	3 9. 0	2 0 2	1750	-8.7
21	020	0.0 1	2 1 1	1.2	3 2 5	1 2 5	1 2 6 0	-97
22	0.20	0.10	280	0.9	4 5.0	2 5. 2	980	64
2 5	a 2 0	020	3 2 0	1 6	3 3.2	210	1210	-
2 4	0.20	n. 5 0	4 1 0	1.8	3 Q 1	1 9.8	1320	-65
2 5(0)	0.20	0.4 0	4 2 0	2.0	2 8.5	181	1590	-
26	225	210	3 2 5	1.0	40.6	2 & 5	1450	- 5 1
27	0.50	0.10	5 4 6	10	3 4 1	202	1620	-20
20	230	0.20	396	1.8	5 1 6	2 0 5	1520	-
29	0.50	0.30	4 0 5	1.6	3 Q.6	2 0 2	1810	_
3 D (20	0.3.5	Q 3 5	400	16	2 B. 6	1 7. 9	1910	
5 1W	040	600	4 4 8	2 0	212	1 3 5	200 a	-
3 2	0.40	0.10	424	1.1	205	1 6 5	1880	-53
5 3 (P)	040	0.20	4 1 5	1.0	1 2 5	1 5.6	1720	
- 7							i	

退相になり、かつ分額も困災となり、所定の特 性質を示さなくなる。

したがつて、本発明の圧電磁器材料の組成范囲を第1図の多角形A-B-C-D-E-Fの 短囲内に限定するものである。

以上、詳細に説明したように $(L_{i_{1-x}}N_{a_{1}})$ $(T_{a_{1}},N_{b_{1-y}})O_{3}$ で构成された本発明の圧電磁器材料は、すぐれた特性を示するのである。

すなわち、 4 で 9 0 ~ 4 7 0、 tan b で 0 7 ~ 2 0 5 Kt で 2 0 ~ 4 9 5、 Kp で 1 4 5 ~ 2 5 3、Qm で 1 0 0 0 ~ 2 0 0 0 の 範囲で任意の特性のものが 初られる。

また、かかる厳特性を適宜調整することができるばかりでなく、tan &もきわめて小さいものであり、広帯域セラミックフィルタ用最適子など、きわめて広い応用分野のあるすぐれた圧口磁波材料を提供し得るものである。

4回回の日午なは明。

第1國は本発明の圧電磁器材料の迅成図であ

特問の49... 33907 (3) 第1表よりあきらかなごとく、本発明になる 圧口磁器材料は、従来の各征圧口磁器材料に比 はしてすぐれた特性値を有していることがわか

すなわち、 σ で 9 0 ~ 4 7 0、 tan 8 で tan 7 ~ 2 0 s 、 K_1 で 2 0 ~ 4 9 s 、 K_p で 1 4 s ~ 2 5 s 、 Q_m で 1 0 0 0 ~ 2 0 s Q なるすぐれた特性を示し、かつ f r · TC のきわめて小さいらのである。

すなわち、特に高端被用圧は磁器材料として 4/6。が1 0 0 租赁で 4Kiが 4 0 ~ 5 0 5 と大なる値を示し、かつ fir-TC がきわめて小さい 位であり、多くの特徴を有しているととがわかる。

第1図は、本発明の圧は磁器材料の母成范囲を示す困元図であり、図中の哲号は第1表の試料証号に対応している。

本籍明の圧で磁器材料は、組成点A、B、C、D、E、Fで形成される多角形A-B-C-D-E-Fの路囲内の組成を有するものである。
この路器外にかいては、初られる磁器は二相の

特所出版人 以京灯纸化学工泉株式会社 代表者 尽 好 初 太 邸

-35-

* 1 10

Na NbOs

NaTa Os

特別 1749-- 33907 (4)

4. 添附書類の目録

(1) 出願密査請求書
 (2) 明 和 書
 (3) 図 而
 (4) 願 書 副 本
 1 通
 1 通
 5. 前限以外の発明者